

Zn(HPB)₂와 Zn(HPB)q를 이용한 White OLED의 색순도 향상에 관한 연구

장수현, 백선진, 최규채, 이학대, 권영수*
 동아대학교 전기공학과

Improvements of Color Purity in White OLED using Zn(HPB)₂ and Zn(HPB)q

Su-Hyun Jang, Sun-Jin Back, Kou-Chea, Choi, Hak-Dae Lee, Young-Soo Kwon*
 Department of Electrical Engineering, Dong-A University

Abstract - Organic light emitting diodes (OLEDs) show a lot of advantages for display purposes. Because OLEDs provide white light emission with a high efficiency and stability, it is desirable to apply OLEDs as an illumination light source and back light in LCD displays. We synthesized new emissive materials, namely Zn(HPB)₂ and Zn(HPB)q, which have a low molecular compound and thermal stability. We studied white OLEDs using Zn(HPB)₂ and Zn(HPB)q. The fundamental structures of the white OLEDs were ITO / NPB (40 nm) / Zn(HPB)₂ (40 nm) / Zn(HPB)q (20 nm) / LiAl (120 nm). As a result, we obtained a maximum luminance of 15325 cd/m² at a current density of 997 mA/cm². The CIE (Commission International de l'Eclairage) coordinates are (0.28, 0.35) at an applied voltage of 9.75 V.

1. 서 론

White OLED는 양 전극 사이에 놓인 단층 또는 다층의 유기물에서 백색을 발광하는 OLED 소자이다 [1]. White OLED는 1995년 Yamagata 대학의 Kido 교수가 적색, 녹색, 청색 발광 특성을 갖는 발광층을 적층하여 백색 발광 특성을 보인 이래로 고효율, 장수명 특성을 가지며 색순도가 우수한 소재 및 소자 개발을 위한 연구가 꾸준히 이루어지고 있다 [2]. White OLED는 대면적 고화질의 OLED 디스플레이로의 응용성뿐만 아니라 LCD 백라이트와 일반 조명 등의 다양한 응용 가능성으로 인하여 국내외 연구자들에 의하여 본격적인 연구가 이루어지고 있다. 특히, White OLED 기술의 새로운 응용분야로서 일반 조명으로 활용하고자 하는 연구는 선진국을 중심으로 활발하게 이루어지고 있다 [3]. OLED와 무기 LED와 같은 고체 상태광원(Solid State Lighting)이 기존의 형광등과 백열등 같은 가스 상태 광원(Vapor State Lighting)에 비하여 에너지 효율이 매우 높아 에너지 절약 측면에서 그 중요성이 대두되고 있다 [4].

기존의 백라이트가 갖지 못하는 장점을 지닌 고효율의 White OLED 패널을 개발한다면, 변환장치가 필요 없기 때문에 얇고 가벼운 백라이트 제품을 기대할 수 있고, 소비전력이 낮고 화면을 균일하게 조명할 수 있기 때문에 고부가가치의 LCD 디스플레이 장치를 구현할 수 있다. 이와 동시에 차세대 디스플레이로 유망한 풀컬러 OLED 디스플레이에도 핵심 재료로 이용 가능하며, 또한 면조명 등의 광원 용도에도 응용도 가능하리라 예측 된다 [5].

본 논문에서는 blue 발광 물질인 Zn(HPB)₂와 yellowish green 발광 물질인 Zn(HPB)q를 이용해서 Zn(HPB)q의 두께 변화에 따른 white OLED의 색순도 향상에 관한 연구를 진행하였다.

2. 실험

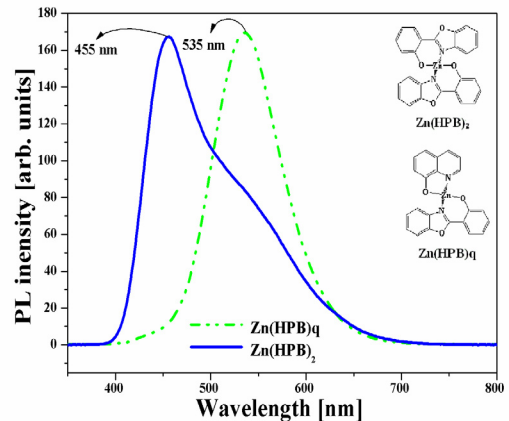
본 실험에서는 ITO를 양극으로, Li:Al을 음극으로 각각 사용하였다. 소자제작에 사용한 ITO 박막의 두께는 120 nm이었으며 표면 저항은 10 Ω/cm² 이었다. 소자의 발광면적은 3 mm × 3 mm 크기로 하였다. 유기물을 증착하기 전에 ITO 기판을 1분 동안 UV-Ozone 표면처리 하였다. UV-Ozone 표면 처리는 ITO 표면에 잔존해 있는 불순물을 제거하여 OLED 효율을 향상 시킨다. 유기물과 금속의 증착은 5×10⁻⁶ torr 진공도에서 1.0 Å/s, 10 Å/s의 증착율로 각각 증착하였다. 소자구조는 ITO / NPB (40 nm) / Zn(HPB)₂ (40 nm) / Zn(HPB)q / Alq₃ (10 nm)/Li:Al (120 nm)로 제작하였으며, Zn(HPB)q의 두께를 20 nm, 30 nm, 40 nm로 변화시켜서 실험을 진행하였다. 표 1은 소자구조를 나타내었다.

표 1. 소자구조

	소자 구조
Device1	ITO/NPB(40nm)/Zn(HPB) ₂ (40nm)/Zn(HPB)q(20nm)/LiAl
Device2	ITO/NPB(40nm)/Zn(HPB) ₂ (40nm)/Zn(HPB)q(30nm)/LiAl
Device3	ITO/NPB(40nm)/Zn(HPB) ₂ (40nm)/Zn(HPB)q(40nm)/LiAl

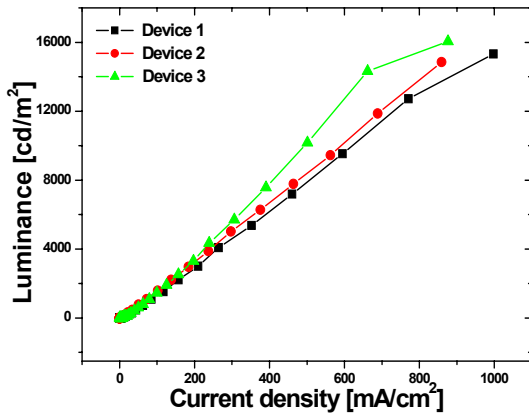
3. 결 과

그림 1에 Zn(HPB)₂와 Zn(HPB)q의 분자구조와 PL 스펙트럼을 각각 나타내었다. Zn(HPB)₂와 Zn(HPB)q의 PL 피크는 455 nm와 535 nm로 각각 관찰되었다. Zn(HPB)₂는 Blue 발광, Zn(HPB)q는 Yellowish Green 발광하는 것을 확인할 수 있었다.

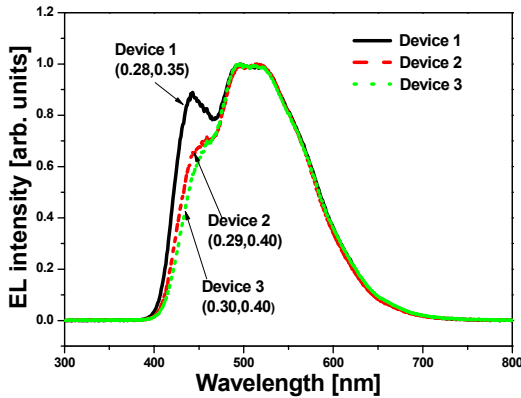


<그림 1> Zn(HPB)₂, Zn(HPB)q의 PL 스펙트럼 및 분자 구조

그림 2는 본 실험에서 사용된 소자의 휘도-전류밀도 특성을 나타낸 것이다. 그림 3에 Zn(HPB)q의 두께에 따른 EL 스펙트럼을 나타내었다. Zn(HPB)q의 두께가 증가할수록 Blue 피크가 감소함을 확인 할 수 있다.

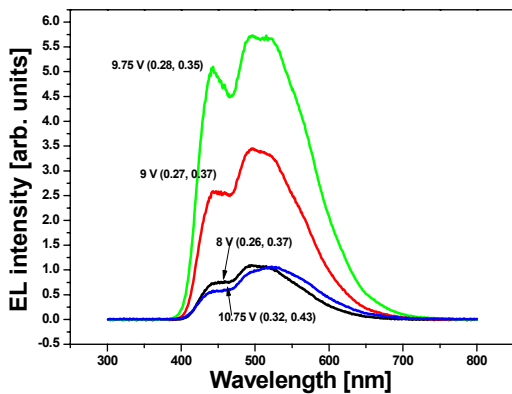


<그림 2> 소자의 휘도-전류밀도 특성



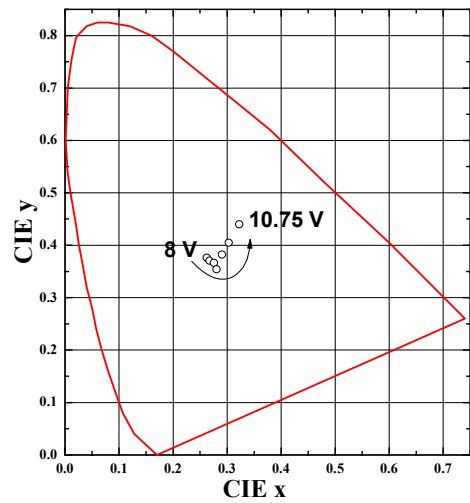
<그림 3> 각 소자의 EL 스펙트럼

그림 4는 Device 1의 EL 스펙트럼을 나타낸 것이다. 전압이 증가할수록 blue 발광이 증가하여 2개의 피크가 나타남을 확인할 수 있다.



<그림 4> Device 1의 EL 스펙트럼

그림 5에 Device 1의 구동 전압 변화에 따른 CIE 좌표 변화를 나타내었다. 구동 전압이 증가 할수록 CIE 좌표는 8 V 일 때 (0.26, 0.37), 9.75 V 일 때 (0.28, 0.35), 그리고 10.75 V 일 때 (0.32, 0.43)로 나타났다. 저전압에서는 Zn(HPB)₂의 휘도가 EL 소자의 적은 영향을 주지만, 전압이 증가 할수록 blue 피크가 증가하여 Zn(HPB)₂의 휘도가 EL 소자의 영향을 주는 것을 확인할 수 있다. 이것은, 구동 전압이 증가할수록 Bluish Green에서 White 발광으로 변화한다는 것을 나타내는 것이다. 이러한 변화는 전압이 증가 할수록 소자의 Main Exciton Recombination 지점이 Zn(HPB)₂ 경계에서 점차적으로 Zn(HPB)q 경계로 이동한 것으로 생각된다. 소자의 Min Exciton Recombination 지점의 변화가 EL 스펙트럼 및 CIE 좌표에 영향을 미치는 것으로 생각할 수 있다.



<그림 5> Device 1의 구동 전압에 따른 CIE 좌표

4. 결 론

본 연구에서는 발광 물질인 Zn(HPB)₂와 Zn(HPB)q를 합성하여 이중 발광층 구조를 가지는 White OLEDs를 제작하였으며, Zn(HPB)q의 두께를 변화시켜서 소자를 각각 제작하였다. 그 결과 Zn(HPB)q의 두께가 20 nm 일 때 White OLED의 최고 휘도는 15171 cd/m²임을 확인 하였다. 그리고 CIE 좌표는 구동전압이 9.75 V 일 때 (0.28, 0.35)로 측정되어 백색을 발광하는 것을 확인하였다.

[참 고 문 헌]

- [1] S. Tao, Z. Peng, X Zhang, S. Wu, J. Lumin., 121, 568, 2006.
- [2] D. E. Kim, W. S. Kim, B. J. Lee, Y. S. Kwon, Jpn. J. Appl. Phys., 46, 2749, 2007.
- [3] J. Kido, W. Ikeda, M. Kimura and K. Nagai, Jpn. J. Appl. Phys., 35, L394, 1996
- [4] M. Mazzeo, D. Pisignano, L. Favaretto, G. Sotgiu, G. Barbarella, R. Cingolani and G. Gigli, Synthetic Metals, 139, 675, 2003.
- [5] X. Y. Jiang, Z. L. Zhang, B. X. Zhang, W. Q. Zhu, S. H. Xu, Synthetic Metals, 129, 9, 2002.